01.1

Влияние теплофизических свойств подложки анизотропного термоэлемента на величину термоэдс в стационарном тепловом режиме

© С.В. Бобашев, П.А. Попов, Б.И. Резников, В.А. Сахаров

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург E-mail: pavel.popov@mail.ioffe.ru

Поступило в Редакцию 29 ноября 2015 г.

Выполнено численное моделирование тепловых и термоэлектрических процессов в анизотропных термоэлементах, расположенных на подложках из различных материалов. Показано, что при неизменном тепловом потоке, проходящем через термоэлемент, теплофизические свойства подложки и коэффициент теплоотдачи на ее тыльной поверхности существенно влияют на распределение температуры и величину генерируемой термоэдс.

Анизотропные термоэлементы широко применяются в генераторах термоэдс, устройствах охлаждения [1,2], тепловых датчиках [3,4] и приемниках лучистых потоков [5]. Большое количество работ посвящено исследованию влияния анизотропии свойств материала термоэлемента на генерируемую им термоэдс [6]. Традиционно считается, что влияние анизотропии теплопроводности пренебрежимо мало. Данное утверждение можно считать справедливым только для определенных граничных условий на поверхности термоэлемента, при которых распределение температуры близко к одномерному. В данной работе анализируется влияние анизотропии теплопроводности, когда термоэлементы применяются в качестве тепловых датчиков. Это определяет тип граничных условий и выбор материала подложки, на которой закреплен термоэлемент.

Рассмотрим сборку, состоящую из анизотропного термоэлемента (1) прямоугольной формы длиной l и толщиной h, расположенного на непроводящей подложке (2) толщиной s (рис. 1). Через рабочую поверхность термоэлемента y = h проходит постоянный тепловой поток плотностью q_h , боковые поверхности термоэлемента и подложки x = 0

32



Рис. 1. Расчетная область: *I* — анизотропный термоэлемент, (2) — подложка, *A*, *B* и *C* — точки регистрации генерируемой термоэдс.

и x = l теплоизолированы. На тыльной поверхности подложки y = -s осуществляется конвективный теплообмен $q_s = \alpha_s (T_s - T_e)$, где α_s — коэффициент теплоотдачи, T_s и T_e — температура подложки и окружающей среды. На всех поверхностях термоэлемента задается условие электроизоляции. Генерируемая термоэдс регистрируется между точками A и B, расположенных на рабочей поверхности y = h.

Стационарное распределение температуры и электрического потенциала находится из решения системы уравнений теплопроводности и электропроводности [5].

$$div j = 0,$$
$$div q = 0,$$

где $j = -\sigma \nabla \varphi - \sigma \alpha \nabla T$, $q = -\lambda \nabla T$ — плотность электрического тока и потока тепла, T — температура, φ — электрический потенциал, σ , α , λ — тензоры электропроводности, термоэдс и теплопроводности. Учитывается анизотропия теплопроводности, электропроводности и термоэдс материала термоэлемента, свойства подложки изотропны.

Физические свойства материалов задавались постоянными. В модели не учитывается выделение теплоты Джоуля, Томсона и Бриджмена в силу их пренебрежимо малого влияния на распределение температуры. Численное решение системы уравнений с заданными граничными условиями проведено в пакете COMSOL Multiphysics в коэффициентной форме.

Для верификации расчетной модели термоэлемента использовались экспериментальные данные, полученные при стационарной калибровке градиентного датчика теплового потока (ГДТП) [3]. Датчик размером в плане 2.2 × 2.2 mm представлял собой батарею из 10 последовательно соединенных термоэлементов из висмута длиной $l = 2.2 \,\mathrm{mm}$ и толщиной $h = 0.2 \,\mathrm{mm}$, закрепленных на подложке из слюды. Калибровка проводилась на специальном стенде при заданной плотности теплового потока $q_h = 100 \, \text{kW/m^2}$, проходящего через рабочую поверхность датчика. Выходной сигнал ГДТП составил U = 6.8 mV. По результатам расчета, соответствующего условиям данного эксперимента, разность потенциалов между точками A и B составила $\Delta \varphi_{AB} = 0.43 \,\mathrm{mV}$, а суммарная разность потенциалов батареи $\Delta \phi = 4.3 \,\mathrm{mV}$. Поскольку в силу анизотропии свойств материала термоэлемента изопотенциальные линии имеют некоторый наклон относительно рабочей поверхности, то максимальная разность потенциалов создается между диагонально расположенными точками А и С (рис. 1). В этом случае разность потенциалов батареи составила $\Delta \phi = 6.5 \,\mathrm{mV}$. Отличие результатов расчета от экспериментальных данных не превышает 35%, и полученные в тестовом расчете результаты можно признать удовлетворительно совпадающими с опытными данными.

Рассмотрим влияние теплофизических свойств подложки на распределение температуры в термоэлементе и генерируемую им термоэдс. Через рабочую поверхность термоэлемента проходит постоянный тепловой поток $q_h = 10^5 \text{ kW/m}^2$. Рассмотрим два случая, когда температуропроводность $a = \lambda/C\rho$ (здесь C — теплоемкость, ρ — плотность) термоэлемента и подложки близки $a_{(1)} \approx a_{(2)}$ и значительно различаются $a_{(1)} \ll a_{(2)}$. Первый случай соответствует расположению термоэлемента на теплоизоляционном материале, например слюде с $a \sim 10^{-7} \text{ m}^2$ /s, а второй — расположению на металле, например, на меди с $a \sim 10^{-4} \text{ m}^2$ /s. Рассматриваемый диапазон теплофизических свойств материала подложки соответствует возможным условиям использования теплового датчика на анизотропных термоэлементах.



Рис. 2. Поле температуры (a, b) в сборке анизотропный термоэлемент — подложка и поле потенциала в термоэлементе (c, d) в случае подложки с низкой (a, c) и высокой температуропроводностью (b, d).

На рис. 2 показаны рассчитанные поля температуры и электрического потенциала в случае термоэлемента из висмута с соотношением сторон l/h = 10 для рассматриваемых вариантов материала подложки. В качестве точки отсчета использовалась минимальная температура во всей расчетной области. Видно, что при одинаковой плотности теплового потока q_h распределение температуры различно. В случае подложки с малой температуропроводностью во всем термоэлементе изотермы имеют практически одинаковый наклон относительно рабочей поверхности, определяемый анизотропией теплопроводности. Подложка с большой температуропроводностью существенно влияет на распределение температуры в термоэлементе, и оно становится близко к одномерному. В этом случае влияние анизотропии теплопроводности сказывается только вблизи его торцов. Различается также и распределение теплового потока q_0 на тыльной поверхности термоэлемента y = 0, в случае подложки с большой температуропроводностью оно существенно неоднородно. Поскольку поля температуры различны, то будут отличаться направление и величина вектора градиента температуры, определяющего термоэлектрическое поле $\mathbf{E}^T = -\alpha \nabla T$ (рис. 2). В силу анизотропии термоэдс изменится соотношение между его продольной и поперечной компонентами, что в итоге приводит к изменению суммарной термоэдс, генерируемой термоэлементом.

Рассмотрим теперь влияние отношения длины к толщине термоэлемента l/h на генерируемую термоэдс. Остальные параметры расчета аналогичны предыдущему. На рис. 3, *а* показана зависимость $\Delta \varphi / \Delta \varphi^*$ от отношения сторон l/h. В качестве масштаба выбрана термоэдс квадратного термоэлемента единичной длины $\Delta \varphi^*$. Линии *l* и *2* соответствуют расположению термоэлемента на подложке с высокой и низкой температуропроводностью соответственно. Видно, что при одинаковых геометрических размерах в силу различного распределения температуры различается и величина термоэдс. На рис. 3, *b* показано относительное изменение термоэдс ($\Delta \varphi_1 - \Delta \varphi_2$)/ $\Delta \varphi_1$ на подложках с различной температуропроводностью. Видно, что при практически важном соотношении сторон l/h = 10-20 отличие генерируемой термоэдс достигает 40%.

В работе [7] предлагается рассчитывать генерируемую термоэдс по формуле $\Delta \phi = q_h \Delta \phi^* l$, где $\Delta \phi^*$ — термоэдс термоэлемента единичной длины, l — длина рабочей поверхности термоэлемента. Линия 3 на рис. 3 соответствует расчету генерируемой термоэдс по этой формуле. Видно, что данный способ расчета дает существенные погрешности в



Рис. 3. a — зависимость генерируемой термоэдс $\Delta \varphi / \Delta \varphi^*$ от отношения сторон l/h термоэлемента при постоянном проходящем через него тепловом потоке. Линии l и 2 — случай подложки с высокой и низкой температуропроводностью, линия 3 — расчет термоэдс по формуле $\Delta \varphi = q_h S \Delta \varphi^*$. b — относительное изменение термоэдс ($\Delta \varphi_1 - \Delta \varphi_2$)/ $\Delta \varphi_1$ для различных соотношений сторон термоэлемента l/h и расположенных на подложках с различными теплофизическими свойствами.

случае достаточно длинных термоэлементов, поскольку с увеличением отношения l/h изменяется вклад продольной и поперечной термоэдс. Кроме того данный подход не позволяет учесть влияние теплофизических свойств материала подложки на распределение температуры в термоэлементе и соответственно генерируемую им термоэдс.

Необходимо также отметить, что для подложки с малой температуропроводностью при неизменной плотности теплового потока q_h генерируемая термоэдс существенно зависит от интенсивности теплообмена на тыльной поверхности. При соотношении сторон термоэлемента l/h = 10 и изменении коэффициента теплоотдачи $\alpha_s = 10-1000 \text{ W/(m \cdot K)}$ уменьшение термоэдс не превышает 5%, а при l/h = 100 достигает 30%. Это также является следствием перестроения поля температуры в силу анизотропии теплопроводности материала термоэлемента. Для подложек с большой температуропроводностью данный эффект не наблюдается.

Результаты расчетов показывают, что при одном и том же тепловом потоке, проходящем через термоэлемент, теплофизические свойства материала подложки и интенсивность теплообмена на ее тыльной поверхности существенно влияют на распределение температуры и генерируемую термоэдс. При использовании термоэлементов в качестве генераторов термоэдс расположение их на подложках с высокой температуропроводностью вместо изоляционных материалов позволяет увеличить до 40% генерируемую термоэдс. В случае тепловых датчиков на анизотропных термоэлементах при высоких требованиях к точности измерений стационарная калибровка датчика должна проводиться на подложке с теплофизическими свойствами, близкими к свойствам поверхности, на которой предполагается проводить измерения. Также следует отметить, что датчики с различными размерами термоэлементов необходимо калибровать индивидуально, в силу различного вклада продольной и поперечной термоэдс. Полученные результаты применимы к различным материалам, обладающим анизотропией теплопроводности и термоэдс.

Список литературы

- [1] Анатычук Л.И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства. Справочник. Киев: Наук. думка, 1979. 768 с.
- [2] Анатычук Л.И. Термоэлектричество. Т. 2. Термоэлектрические преобразователи энергии. Киев: Институт термоэлектричества, 2003. 376 с.

- [3] Andrey V. Mityakov, Sergey Z. Sapozhnikov, Vladimir Y. Mityakov, Andrei A. Snarskii, Maxim I. Zhenirovsky, Juha J. Pyrhönen // Sen. Actuators, A: Physical. 2012. V. 176. P. 1–9.
- [4] Сапожников С.З., Митяков В.Ю., Митяков А.В. Основы градиентной теплометрии. СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2012. 203 с.
- [5] Ащеулов А.А., Гуцул И.В. // ФТП. 2006. Т. 40. В. 8. С. 995–1003.
- [6] Снарский А.А., Пальти А.М., Ащеулов А.А. // ФТП. 1997. Т. 31. В. 11. С. 1281–1298.
- [7] Королюк С.Л., Пилат И.М. и др. // ФТП. 1973. Т. 7. В. 4. С. 725-734.